

平成24年度
物理学専攻 大学院修士課程
入学試験問題

物理学 [I] (125点)

平成23年8月31日 (水) 13:00-14:20

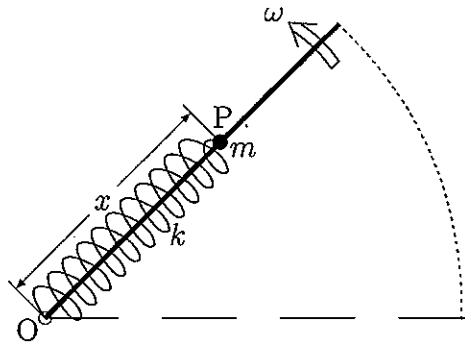
注意事項

1. 指示があるまでは、問題冊子ならびに解答冊子を開かないこと。
2. 問題冊子1部、解答冊子1部が配布されていることを確認すること。
3. 「はじめ」の指示があったら、解答を始める前に、まず問題冊子に表紙1枚と問題用紙が2枚、解答用紙が2枚あることを確認し、すべての解答用紙に受験番号と氏名を記入すること。
4. 問題 [I-A] および [I-B] の解答は、それぞれ指定の解答用紙に記入すること。
5. 解答に際しては、最終的な答だけでなくその答に到る道筋も丁寧に記入すること。
6. 解答用紙は裏面も使ってよい。それでも足りない場合は、試験監督に申し出ること。
7. 「おわり」の指示があったら、直ちに鉛筆を置くこと。
8. 試験終了後、解答冊子は回収するが、問題冊子は持ち帰って良い。

物理学 [I]

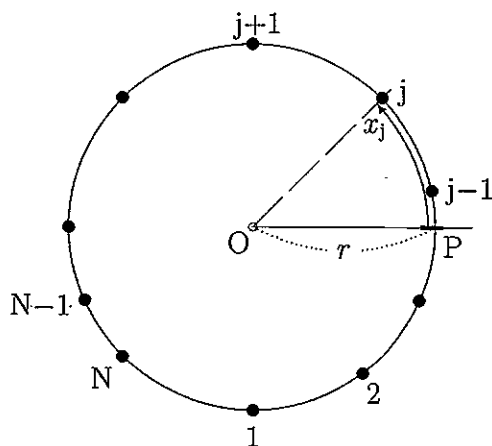
以下の問に、答えの導出過程も含めて解答せよ。なお、物理量 X の時間微分は \dot{X} と記す。

[I-A] 図に示すように、水平面上に置かれた十分に長い直線の棒が、一方の端が点 O に固定されて、 O を中心に一定の角速度 ω で回転している。棒には、質量 m の質点 P が取り付けられており、棒にそって摩擦なく滑らかに動くことができる。点 O と質点 P の間は、棒にそって伸び縮みするバネでつながれている。バネは自然長が l 、バネ定数は k で、質量は無視できるとする。点 O から質点 P までの距離を x とする。



- (A-1) バネのポテンシャルエネルギー U を、バネが自然長のときに $U = 0$ として求めよ。
- (A-2) 点 O を原点とする慣性系から見たときの、質点 P の運動エネルギー T を求めよ。
- (A-3) 質点とバネで構成された力学系のラグランジアン L を求めよ。
- (A-4) x についてのオイラー・ラグランジュ方程式を求めよ。
- (A-5) 慣性系から見ると、棒は質点に外力をおよぼして仕事をしているので、質点とバネの系のエネルギー $E = T + U$ は保存しない。距離 x が $\dot{x} > 0$ で変化しているとき、質点が棒から受ける力の大きさ F およびその向きを求めよ。
- (A-6) (A-3) で求めたラグランジアンの特徴からすぐにわかる保存量がある。保存する理由を述べて、その保存量を書き下せ。

[I-B] 図に示すように、水平面に置かれた半径 r の円の円周上を、質量 m の N 個の質点 $j = 1, 2, \dots, N$ が、摩擦なく滑らかに動くことができる。各質点 j の位置を、円周上の基準点 P から質点まで円周にそって反時計回りに計った距離 x_j で表わす。



それぞれの質点 j は、質点 $j+1$ と質点 $j-1$ の円周にそった速度の差に比例した力を受ける。その比例定数を a とおき、運動方程式を

$$m\ddot{x}_j = a(\dot{x}_{j+1} - \dot{x}_{j-1}) \quad j = 1, 2, \dots, N \quad (1)$$

とする。ここに $x_{N+1} \equiv x_1$, $x_0 \equiv x_N$ である。質点の運動は、円周上で互いに衝突しない範囲内におさまっているとする。以下で i は虚数単位である。

(B-1) 円の中心 O のまわりの全角運動量

$$l = mr \sum_{j=1}^N \dot{x}_j \quad (2)$$

が時刻 t によらない保存量であることを示せ。

(B-2) 全運動エネルギー

$$T = \frac{1}{2}m \sum_{j=1}^N \dot{x}_j^2 \quad (3)$$

が時刻 t によらない保存量であることを示せ。

(B-3) 質点の総数を $N = 3$ とする。3成分のベクトル \mathbf{v} を

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} \quad (4)$$

で定義し、運動方程式 (1) を 3 行 3 列の行列 A をもちいて

$$m\dot{\mathbf{v}} = A\mathbf{v} \quad (5)$$

と書く。行列 A は反対称行列である。その具体的な形を求めよ。

(B-4) $2\pi/3$ の位相をもった因子 $\epsilon = e^{i2\pi/3}$ によって3個のベクトル $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ を

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ \epsilon \\ \epsilon^2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ \epsilon^2 \\ \epsilon \end{pmatrix} \quad (6)$$

と定義する。等式 $\epsilon^* = \epsilon^2, \epsilon^3 = 1, 1 + \epsilon + \epsilon^2 = 0$ により、これらは $\mathbf{u}_j^\dagger \mathbf{u}_k = \delta_{jk}$ ($j, k = 1, 2, 3$) を満たす規格直交ベクトルである。これらのベクトルはエルミート行列 iA の固有ベクトル

$$iA\mathbf{u}_j = \lambda_j \mathbf{u}_j \quad j = 1, 2, 3 \quad (7)$$

になっている。固有値 λ_j ($j = 1, 2, 3$) を求め、それぞれの値を $0, \pm a, \pm\sqrt{2}a, \pm\sqrt{3}a, \pm 2a$ の中から選んで答えよ。

(B-5) 行列 iA をユニタリー変換 $U^\dagger iA U$ で対角化するユニタリー行列 U を具体的に書き下せ。

(B-6) 3成分の複素ベクトル \mathbf{w} を $\mathbf{w} = U^\dagger \mathbf{v}$ で定義する。時刻 t における \mathbf{w} の各成分 $w_1(t), w_2(t), w_3(t)$ を、 $t = 0$ における初期値 $w_1(0), w_2(0), w_3(0)$ のもとに求めよ。

(B-7) 時刻 $t = 0$ における各質点の初速度を

$$\mathbf{v}(t=0) = \begin{pmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

とする。時刻 t における質点1の速度 $\dot{x}_1(t)$ を求めよ。

(B-8) 質点の総数 N が偶数のときには、1個の質点だけに0でない初速度 v を与えると、 $|v|$ がいかに小さくてもいずれ質点の衝突が起こる。その理由を答えよ。

平成24年度
物理学専攻 大学院修士課程
入学試験問題

物理学〔II〕（125点）

平成23年8月31日（水）14：50－16：10

注意事項

1. 指示があるまでは、問題冊子ならびに解答冊子を開かないこと。
2. 問題冊子1部、解答冊子1部が配布されていることを確認すること。
3. 「はじめ」の指示があったら、解答を始める前に、まず問題冊子に表紙1枚と問題用紙が3枚、解答用紙が2枚あることを確認し、すべての解答用紙に受験番号と氏名を記入すること。
4. 問題〔II-A〕、〔II-B〕および〔II-C〕の解答は、それぞれ所定の解答欄に記入すること。
5. 解答に際しては、最終的な答だけでなくその答に到る道筋も丁寧に記入すること。
6. 「おわり」の指示があったら、直ちに鉛筆を置くこと。
7. 試験終了後、解答冊子は回収するが、問題冊子は持ち帰って良い。

物理学 [II]

- ※ 太い文字(\mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{A} 等)はベクトルを表す。
- ※ 単位系は特に指定しない限り MKSA(SI)を用いる。cgs で解答してもよいがその場合は、解答欄のそれぞれに cgs と明示しなさい。
- ※ ϵ_0 は真空の誘電率, μ_0 は真空の透磁率, Δ はラプラシアンを表す。

[II-A] 真空中を伝播する電磁波を考える。電場 \mathbf{E} が直交座標系(x, y, z)で、 $\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t)$ (E_0 は実定数ベクトル, t は時刻, $k > 0, \omega > 0$) で与えられる時、以下の問いに答えなさい。但し、磁束密度を \mathbf{B} とし、定常磁場はないものとする。

- (1) この波はどちらの方向に進むか。
- (2) 真空中の電場に関するガウスの法則を微分形で書きなさい。
- (3) 問(2)を用いて、 E_0 が xy 平面内になければならないことを示しなさい。
- (4) 電磁誘導に対するマクスウェルの方程式を書きなさい。
- (5) 問(4)を用いて、磁束密度 \mathbf{B} が電場 \mathbf{E} と電磁波の進行方向の両方に垂直であることを示しなさい。
- (6) ポインティングベクトルの定義式を書きなさい。また、それは何を表しているか答えなさい。
- (7) 問(6)を用いて、この電磁波に対するポインティングベクトルの方向を求めなさい。

【II-B】太さが無視できる直線状の電線を通る電流が作る磁場について、以下の問いに答えなさい。

(1) アンペールの法則の積分形を書き、その意味を説明しなさい。

(2) 図 1 a のような直交座標系の y 軸上に、無限に長い直線状の電線がある。その電線を、定常電流 I が y 軸の正の向きに流れている。アンペールの法則を用いて、この電流が点 $(b, 0, 0)$ ($b > 0$) に作る磁束密度 B の z 成分を求めなさい。

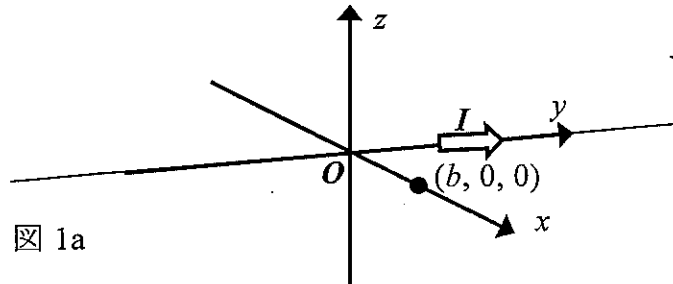


図 1a

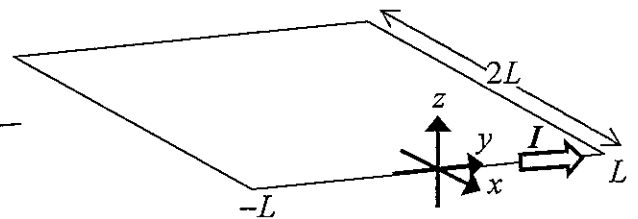


図 1b

問(2)の結果を、ベクトルポテンシャルを使って、以下のように導出しよう。

真空中を通る定常電流が作るベクトルポテンシャル A は、 $\nabla \cdot A = 0$ のゲージの場合

$\Delta A = -\mu_0 j$ (j : 電流密度) を満たし、 j が無限遠でゼロの場合には、解は、

$$A(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int dx' dy' dz' \frac{j(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (\text{E1})$$

で与えられる。但し、 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $\mathbf{r}' = (x', y', z')$ とする。

無限に長い定常電流の代わりに、一辺 $2L$ の大きな正方形の閉回路を考えると(図 1 b)、式(E1)を用いることができる。この回路の一边が y 軸上 $-L$ から L にあるとして、以下に答えなさい。

(3) 一般の場合について、ベクトルポテンシャル A と磁束密度 B の関係を書きなさい。

(4) 図 1 b の y 軸上の電流は、 $\mathbf{j} = I \delta(x) \delta(z) \hat{y} (-L \leq y \leq L)$ と表わされる。ここで、 $\delta(x)$ と $\delta(z)$ はデルタ関数、 \hat{y} は y 方向の単位ベクトルである。これを用いて、 y 軸上の定常電流が作るベクトルポテンシャルの表式を導きなさい (y 方向の積分の計算はしなくてよい)。

(5) $b \ll L$ の時、 y 軸上以外の電流が $(b, 0, 0)$ に作る磁場は無視できる。このことから、問(4)の結果を用いて、この定常電流が $(b, 0, 0)$ に作る B の各成分を求めなさい。但し、 $L \rightarrow \infty$ として積分を実行しなさい。

[II-C] 図2のように直交座標系をとる。但し、 y 軸は紙面に垂直方向である。1辺 a の正方形の薄い金属板2枚を、 $z=0$ 及び $z=d$ に、 xy 平面に平行に配置し、平行平板コンデンサーを作る。金属板の間($z=\delta$ から $z=d-\delta$ (但し $\delta \ll d$))に比誘電率 ϵ_r ($\epsilon_r > 1$)の誘電体を挿入し、 $z=d$ の電極に電荷 Q を、 $z=0$ の電極に電荷 $-Q$ を与えた。

(a) 及び(b)それぞれの場合について、以下の問いに答えなさい。

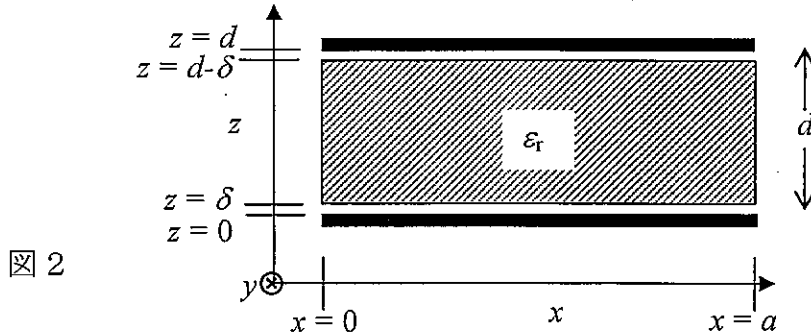


図 2

(a) まず、 $d \ll a$ として、端の効果が無視できるとする。この場合、電場は z 成分のみとしてよい。

- (1) 電束密度 \mathbf{D} に関するガウスの法則を積分形で書きなさい。なお、必要な記号は定義しなさい。
- (2) コンデンサーの外側 $z < 0$ と $z > d$ で、電場の値はいくらか。理由も答えなさい。
- (3) 電束密度に関するガウスの法則を用いて、誘電体内の電場を導出しなさい。

上で求めたように、コンデンサー内の電場は、誘電体がない場合に比べて小さくなる。この原因を理解するために、誘電体の分極 \mathbf{P} により生じた電荷を求めてみよう。尚、分極率は比誘電率を用いて $\epsilon_r - 1$ と与えられる。

- (4) 分極 \mathbf{P} の z 成分 P_z の z 軸に沿った変化を、解答欄のグラフに記入しなさい。適切な z 座標値を書き、誘電体内の電場 E を用いて縦軸に P_z の値を書き入れること。
- (5) この系では電荷がどのように分布しているだろうか。電荷が存在する位置の z 座標とその面電荷密度の値を、符号を含めて全て答えなさい。但し、誘電体内の電場の大きさを E とする。

(b) 次に、 d が a に比べ小さくない場合を考え、端の効果を考慮する。簡単のために、誘電体の影響は無視しなさい。

- (1) 電気力線の分布を図示し、それが $d \ll a$ の場合と比べてどう変わるか説明しなさい。
- (2) 問(b)(1)の結果を基に、端の効果が、電極($z=d$)上の電荷密度の分布にどのような影響を与えるか。定性的に説明しなさい。

平成24年度
物理学専攻 大学院修士課程
入学試験問題

物理学〔III〕（125点）

平成23年8月31日（水）16：40－18：00

注意事項

1. 指示があるまでは、問題冊子ならびに解答冊子を開かないこと。
2. 問題冊子1部、解答冊子1部が配布されていることを確認すること。
3. 「はじめ」の指示があったら、解答を始める前に、まず問題冊子に表紙1枚と問題用紙が2枚、解答用紙が2枚あることを確認し、すべての解答用紙に受験番号と氏名を記入すること。
4. 問題〔III－A〕および〔III－B〕の解答は、それぞれ指定の解答用紙に記入すること。
5. 解答に際しては、最終的な答だけでなくその答に到る道筋も丁寧に記入すること。
6. 解答用紙は裏面も使ってよい。それでも足りない場合は、試験監督に申し出ること。
7. 「おわり」の指示があったら、直ちに鉛筆を置くこと。
8. 試験終了後、解答冊子は回収するが、問題冊子は持ち帰って良い。

物理学 [III]

以下の問題で、 \hbar はプランク定数 h を 2π で割ったもの、 i は虚数単位とする。

[III-A] 1次元ポテンシャル $U(x)$ に束縛された質量 m の粒子の定常状態を考える。粒子の波動関数 $\psi(x)$ が満たすシュレディンガー方程式は

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x)\right) \psi(x) = E\psi(x)$$

である。ここで、 x は粒子の位置座標であり、 E はエネルギー固有値 ($E < 0$) である。

いま、ポテンシャル $U(x)$ は

$$U(x) = \begin{cases} +\infty & x < 0 \text{ のとき} \\ -V & 0 \leq x < a \text{ のとき } (V > 0, a > 0) \\ 0 & x \geq a \text{ のとき} \end{cases}$$

であるとする。以下の問に答えよ。ただし、問8を除きエネルギー固有値 E を求める必要はなく、解答には E を用いてよい。

問1. $x=0$ での境界条件を考慮し、 $0 < x < a$ での波動関数 $\psi(x)$ を求めよ。ただし、 $\psi(x)$ を規格化する必要はなく、適当な未知係数を用いてよい。

問2. $x=+\infty$ での境界条件を考慮し、 $x > a$ での波動関数 $\psi(x)$ を求めよ。ただし、 $\psi(x)$ を規格化する必要はなく、適当な未知係数を用いてよい。

問3. $x=a$ で $\psi(x)$ が満たすべき条件を答えよ。

問4. 基底状態が束縛状態のとき、その波動関数 $\psi(x)$ の概略を描け。

問5. 第一励起状態が束縛状態のとき、その波動関数 $\psi(x)$ の概略を描け。

問6. $k = \frac{\sqrt{2m(V+E)}}{\hbar}$ 、 $\kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$ とすると、問3から $\kappa = -k \cot(ka)$ となる。このことを示せ。

問7. 束縛状態が1つだけのときの V の条件を求めよ。

問8. 問7で求めた V の下限値を V_0 とおく。 V が V_0 よりわずかに大きく

$$V = V_0(1 + \varepsilon)$$

の場合を考える。ここで ε は正で、 $\varepsilon \ll 1$ である。このときの基底状態の E は近似的に

$$E = -\alpha V_0 \varepsilon^2$$

で与えられる。係数 α を求めよ。

[III-B] 電子はスピン角運動量 (以下スピン) という内部状態を持つ。ここでは電子の量子状態のうち、スピン状態のみを考え、空間部分は考えないこととする。

電子のスピン大きさは $s = \frac{\hbar}{2}$ である。量子化軸を z 軸にとると、スピン演算子の z 成分 \hat{s}_z は 2 行 2 列の行列

$$\hat{s}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

で与えられ、その固有値 s_z は $s_z = \pm \frac{\hbar}{2}$ という 2 つの値をとる。 $s_z = +\frac{\hbar}{2}$ の固有ベクトルを α 、 $s_z = -\frac{\hbar}{2}$ の固有ベクトルを β とすると、 α と β は列ベクトルで

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

と表現でき、 α^\dagger と β^\dagger は行ベクトルで

$$\alpha^\dagger = (1 \ 0), \quad \beta^\dagger = (0 \ 1)$$

と書ける。また、スピン演算子の x 成分 \hat{s}_x と y 成分 \hat{s}_y は 2 行 2 列の行列

$$\hat{s}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{s}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

で与えられる。

以下の間に答えよ。

問 1. スピン演算子が軌道角運動量演算子と同じ交換関係

$$[\hat{s}_x, \hat{s}_y] = i\hbar\hat{s}_z$$

を満たすことを示せ。

次に、磁場 $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$ 中の電子について考える。磁場中の電子のハミルトニアン \hat{H} は

$$\hat{H} = -\mu(B_x\hat{s}_x + B_y\hat{s}_y + B_z\hat{s}_z)$$

で与えられるものとする。ただし、 μ は実数である。

まず、 z 軸方向の一様定常磁場 $\mathbf{B} = (0, 0, B_0)$ の場合を考える。

問 2. ハミルトニアン \hat{H} の固有値と固有ベクトルを求めよ。

更に、 xy 平面内で振動する磁場を加え

$$\mathbf{B} = (b \cos(\omega t), -b \sin(\omega t), B_0)$$

とした場合を考える。ここで、 t は時刻、 b は振動磁場の振幅、 ω は振動の角振動数である。

問 3. ハミルトニアン \hat{H} を 2 行 2 列の行列として具体的に表せ。

問 4. 時刻 t における電子スピンの状態ベクトル $\psi(t)$ を

$$\psi(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

と表す。時間に依存するシュレディンガー方程式から、 $x(t)$ と $y(t)$ が満たす連立微分方程式を求めよ。

問 5. 問 4 で求めた連立微分方程式の解として

$$x(t) = C e^{i\omega t/2} e^{i\omega' t/2}, \quad y(t) = D e^{-i\omega t/2} e^{i\omega' t/2}$$

の形を仮定する。ここで C 、 D 、 ω' は定数である。 C と D が関係式

$$(-\omega - \omega' + \mu B_0)C + (\mu b)D = 0$$

$$(\mu b)C + (\omega - \omega' - \mu B_0)D = 0$$

を満たさなければならないことを示せ。

問 6. 問 5. で導いた関係式が非自明な解を持つためには、 ω' が

$$\omega' = \pm \Omega, \quad \Omega = \sqrt{(\omega - \mu B_0)^2 + (\mu b)^2}$$

でなければならないことを示せ。

問 7. 問 4 で求めた連立微分方程式の一般解を求めよ。ただし、状態ベクトルを規格化する必要はなく、解答には Ω を用いてよい。また、初期条件から定まる未定定数は適当に定義せよ。

問 8. 初期条件として

$$x(0) = 1, \quad y(0) = 0$$

の場合を考える。 $y(t)$ を求めよ。ただし、解答には Ω を用いてよい。

平成24年度
物理学専攻 大学院修士課程
入学試験問題

物理学〔IV〕（125点）

平成23年9月1日（木）9：00－10：20

注意事項

1. 指示があるまでは、問題冊子ならびに解答冊子を開かないこと。
2. 問題冊子1部、解答冊子1部が配布されていることを確認すること。
3. 「はじめ」の指示があったら、解答を始める前に、まず問題冊子に表紙1枚と問題用紙が3枚、解答用紙が3枚あることを確認し、すべての解答用紙に受験番号と氏名を記入すること。
4. 問題〔IV－A〕、〔IV－B〕および〔IV－C〕の解答は、それぞれ指定の解答用紙に記入すること。
5. 解答に際しては、最終的な答だけでなくその答に到る道筋も丁寧に記入すること。
6. 解答用紙は裏面も使ってよい。それでも足りない場合は、試験監督に申し出ること。
7. 「おわり」の指示があったら、直ちに鉛筆を置くこと。
8. 試験終了後、解答冊子は回収するが、問題冊子は持ち帰って良い。

物理学 [IV]

以下において、ボルツマン定数を k_B 、プランク定数を h とする。また、 $\hbar = h/2\pi$ とする。

[IV - A] 系の温度 T 、体積 V 、粒子数 N を準静的に変化させる。系の内部エネルギーを E 、エントロピーを S 、圧力を p 、化学ポテンシャルを μ とし、以下の問に答えよ。

- (1) 準静的な微小変化では、 $dE = TdS - pdV + \mu dN$ が成り立つ。この式の右辺各項の意味を説明し、式全体の意味を述べよ。ここに、 dX は X の微小変化を表すものとする。
- (2) 自由エネルギー F をルジャンドル変換 $F = E - TS$ によって導入する。 dE が前問のように与えられるとき、 dF を求めよ。
- (3) 前問の結果をもとに、エントロピー S 、圧力 p 、化学ポテンシャル μ をそれぞれ F の偏微分で表せ。

[IV - B] 温度 T の熱浴に接して熱平衡にある系を考える。

(1) 系が2つの状態のみをとるとし、それらの状態のエネルギー E の値を $+\varepsilon$ と $-\varepsilon$ とする。ここに、 ε は正の定数である。 $+\varepsilon$ の状態をとる確率を p_+ 、 $-\varepsilon$ の状態をとる確率を p_- として ($p_+ + p_- = 1$)、この確率による物理量 Q の期待値を $\langle Q \rangle$ と書くことにする。このとき、以下の間に答えよ。

(1a) p_+ と p_- を ε, T, k_B を用いて表せ。

(1b) $\langle E \rangle$ を p_+, p_-, ε を用いて表せ。

(1c) $T \rightarrow 0$ および $T \rightarrow \infty$ での $\langle E \rangle$ はそれぞれいくらになるか。

(1d) $(\Delta E)^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$ として、 $(\Delta E)^2$ と比熱 C の関係を求めよ。ただし、 $C = \frac{d\langle E \rangle}{dT}$ である。

(1e) 自由エネルギー F を求めよ。

(1f) 前問の結果を用いて、エントロピー S を求めよ。

(1g) $T \rightarrow 0$ および $T \rightarrow \infty$ での S はそれぞれいくらになるか。

(1h) エントロピーが p_+, p_- を用いて、 $S = -k_B(p_+ \log_e p_+ + p_- \log_e p_-)$ と表されることを示せ。

(2) 系のとりうる状態が $1, 2, 3, \dots$ と番号付けできるとし、それらの状態のエネルギーの値を順に E_1, E_2, E_3, \dots とする。 n 番目 ($n = 1, 2, 3, \dots$) の状態をとる確率を p_n としたとき、エントロピー S は、前問 (1h) のように $S = -k_B \sum p_n \log_e p_n$ で与えられるとする。系のエネルギーを E として、 $\sum_n p_n E_n = E$ および $\sum_n p_n = 1$ という条件のもとで、このエントロピー S が極大になるように p_n を決める。

(2a) ラグランジュの未定乗数法を用いて、 p_n が $p_n = A \exp(-\beta E_n)$ の形に書けることを示せ。

以下では、 $p_n = A \exp(-\beta E_n)$ とする。

(2b) S を k_B, A, β, E を用いて表せ。

以下で、 A と β の値を決める。

(2c) 条件 $\sum_n p_n = 1$ から、 A と β の間に成り立つ関係式を求めよ。

(2d) 条件 $\sum_n p_n E_n = E$ と前問で求めた関係式から、 $\frac{d \log_e A}{d\beta} = E$ であることを示せ。

(2e) 熱力学関係式 $\frac{dS}{dE} = \frac{1}{T}$ を用いて β を T で表せ。

[IV - C] 1辺の長さが L の立方体の空間中にあるボース粒子系を考える。以下では、粒子間の相互作用については考えない。系の外側は物質で満たされており、系は温度が T 、化学ポテンシャルが μ の熱平衡状態にあるとする。

- (1) 1粒子状態が $1, 2, 3, \dots$ と番号付けできるとし、それらの状態のエネルギーの値を順に $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots$ ($0 \leq \varepsilon_1 \leq \varepsilon_2 \leq \varepsilon_3 \leq \dots$) とする。 i 番目の1粒子状態の占有数を n_i とすると ($i = 1, 2, 3, \dots$)、全粒子数 N と全エネルギー E は、 $N = \sum_i n_i$ および $E = \sum_i \varepsilon_i n_i$ となる。大分配関数 Ξ は、 $\Xi = \sum_{\{n\}} \exp\left(-\frac{E - \mu N}{k_B T}\right)$ で与えられる。ここに、 $\sum_{\{n\}}$ は n_1, n_2, n_3, \dots についての独立な和 $\sum_{n_1} \sum_{n_2} \sum_{n_3} \dots$ である。

- (1a) 大分配関数が $\Xi = \prod_i \left[1 - \exp\left(-\frac{\varepsilon_i - \mu}{k_B T}\right)\right]^{-1}$ となることを示せ。ここに、化学ポテンシャルは $\mu < \varepsilon_1$ でなければならない。その理由も述べよ。

- (2) 以下では、ボース粒子として光子を考える。光子の内部自由度は2である。立方体の体積を V として ($V = L^3$)、以下の間に答えよ。

- (2a) フォトンの化学ポテンシャルは $\mu = 0$ であるが、この理由を述べよ。

以下では、 $\mu = 0$ とする。

- (2b) 波数ベクトルが \vec{k} の光子のエネルギーを $\varepsilon_{\vec{k}}$ として、自由エネルギー F を \vec{k} についての和として表せ。

以下では、 $\varepsilon_{\vec{k}} = c\hbar k$ とする。ここに、 c は光速、 $k = |\vec{k}|$ である。また、 L は十分に大きくて、 \vec{k} についての和は積分に置き換えてよいものとする。

- (2c) dk が小さいとして、波数ベクトルの大きさが k と $k + dk$ の間にある状態の数が $Vk^2 dk / \pi^2$ であることを示せ。

- (2d) F を k についての積分として表せ。

- (2e) F/V が T^4 に比例することを示せ。

- (2f) 圧力 p はエネルギー密度 $\langle E \rangle / V$ に比例することを示せ。ここに、 $\langle E \rangle$ は全エネルギー E の期待値である。